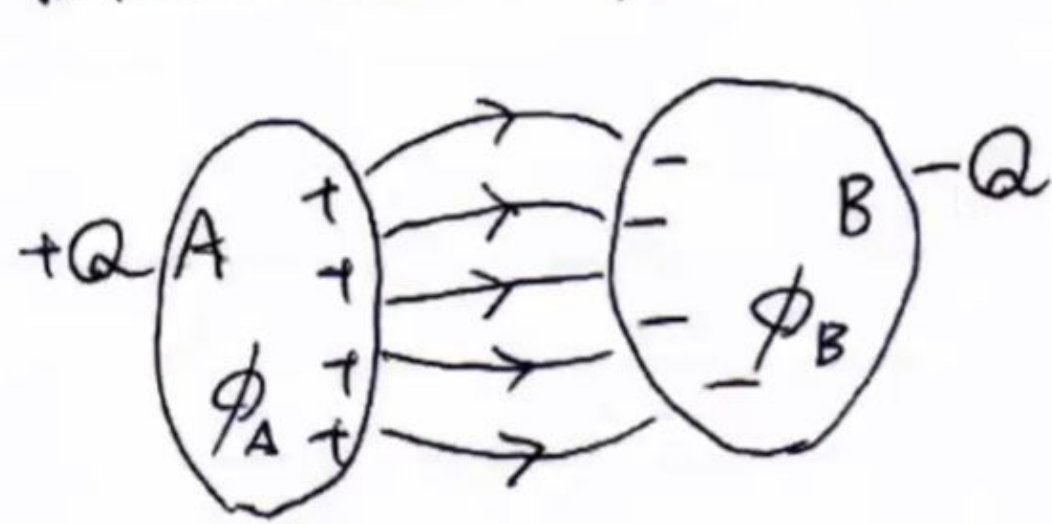


6. 誘電体 (絶縁体)

6.1 コンデンサーと電気容量 (キャパシター)

- ・ 孤立した2つの導体 A と B に $+Q$ と $-Q$ の電荷をそれぞれ与える。



電気力線: $A \rightarrow B$ の表面

電場は主に A, B の間にもみ存在

- ・ このように、常に等量の逆符号の電荷を蓄える
仕組みをコンデンサー (キャパシター) という。

- ・ 導体間の電位差: $\phi_A - \phi_B \equiv V \rightarrow$ “電圧” という。

単位はボルト (V)

電荷 Q と V は比例: $Q = \underline{C} V$

電気容量 (キャパシタンス)

単位はファラド (F)

○ 導体に電荷 Q を与えるとエネルギーが増大。

静電エネルギー $U = \frac{1}{2} \int \rho(r) \phi(r) dV_{\text{体}}$ ^{体積}
に対し、導体では $\phi = \text{一定}$ より、

$$U = \frac{1}{2} \phi \int \underbrace{\rho(r) dV_{\text{体}}}_{=Q} = \frac{1}{2} \phi Q$$

コンデンサー: 2つの導体 A と B に $+Q$ と $-Q$

電位 \downarrow ϕ_A \downarrow ϕ_B



$$\begin{aligned}
 U &= \frac{1}{2}(Q\phi_A - Q\phi_B) \\
 &= \frac{1}{2}Q(\phi_A - \phi_B) \\
 &= \underline{\underline{\frac{1}{2}QV}}
 \end{aligned}$$

$Q = CV$ より、

$$U = \underline{\underline{\frac{1}{2}CV^2}} \quad (\text{コンデンサーの静電エネルギー})$$

$$\bullet \quad U = \frac{1}{2} \int \underbrace{\rho(r)}_{\text{電荷}} \phi(r) dV_{\text{体}}$$

電荷 \Rightarrow 電場 ができる

\Downarrow

電場のエネルギー

平行平板コンデンサー:

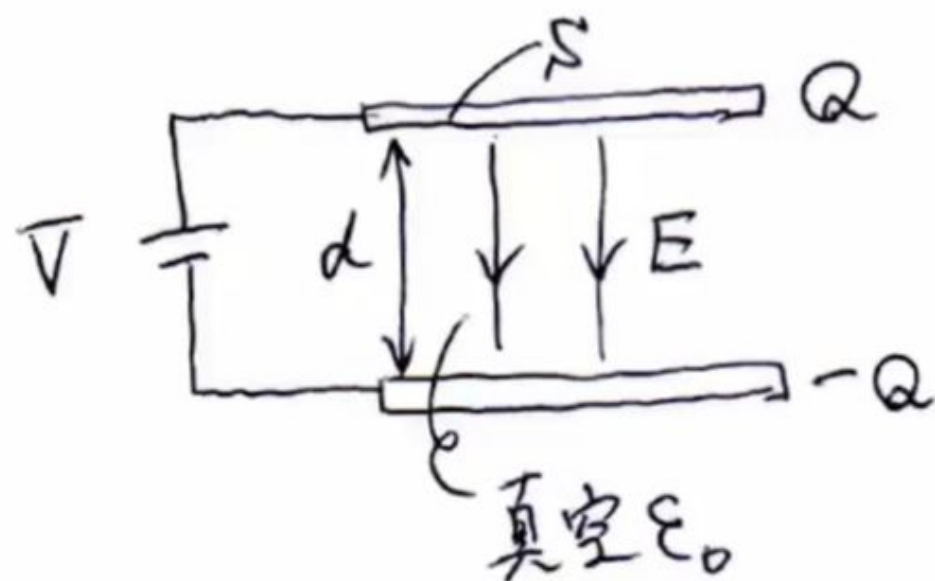
$$\bullet \quad U = \frac{1}{2} \int \underbrace{\rho(r)}_{\text{電荷}} \phi(r) dV_{\text{体}}$$

電荷 \Rightarrow 電場ができる

\Downarrow

電場のエネルギー

平行平板コンデンサー:



+

エネルギーの体積密度を u とすると、

$$U = u \times Sd$$

$$\text{一方、} U = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \times \epsilon_0 \frac{S}{d} \times (Ed)^2$$

$$E = \frac{V}{d}$$

真空 ϵ_0

エネルギーの体積密度を u とすると、

$$U = u \times Sd$$

$$\begin{aligned} \text{一方、} U &= \frac{1}{2} c V^2 = \frac{1}{2} \times \epsilon_0 \frac{S}{d} \times (Ed)^2 \\ &= \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \underbrace{Sd}_{V_{\text{体}}} \end{aligned}$$

ゆえに、

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

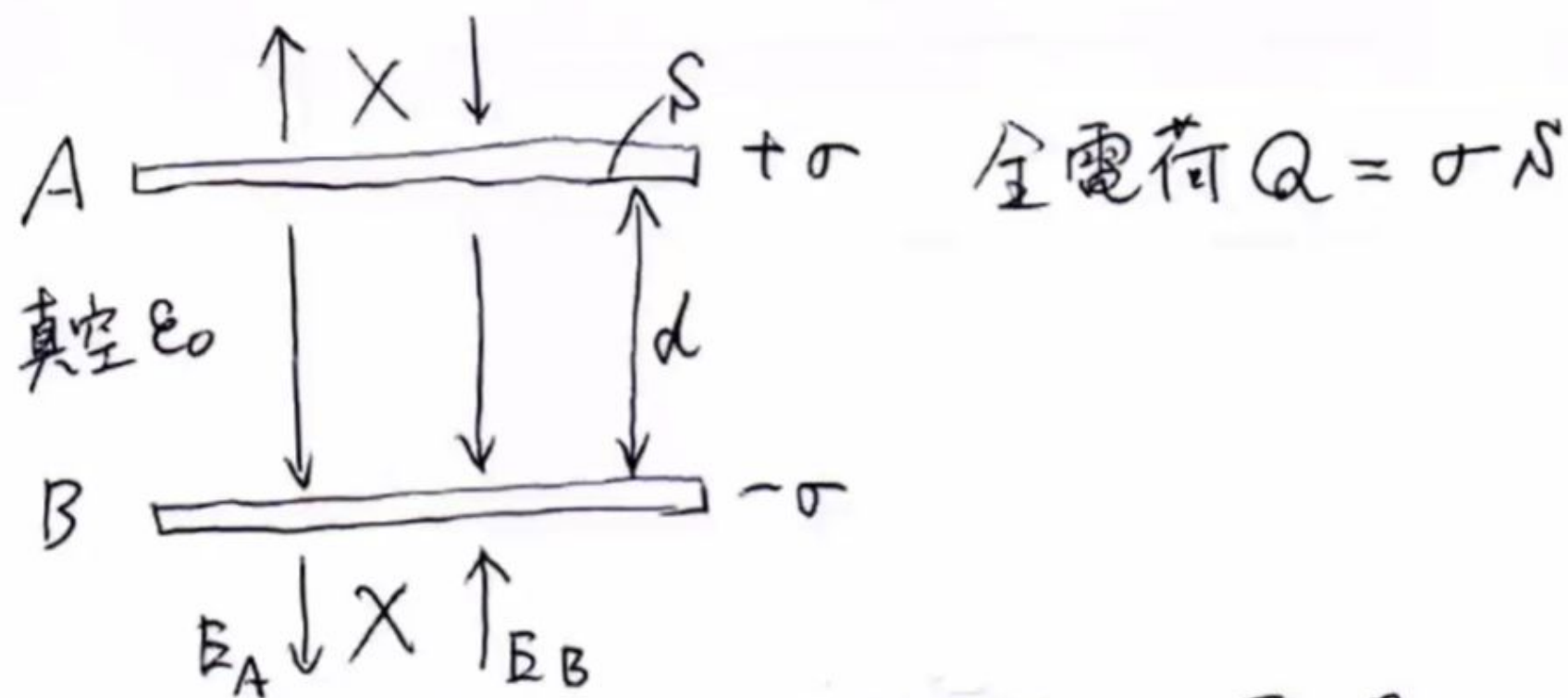
(一般化)

$$u(r) = \frac{1}{2} \epsilon_0 E(r)^2$$

$$U = \frac{1}{2} \epsilon_0 \int_V E(r)^2 dV_{\text{体}}$$



1) 平行平板コンデンサー (p.83, [3])



打消 \longrightarrow 極板間の電場

cf. 演習 p.37 [2] (2)

ガウスの法則より、

$$E_A = E_B = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

$$\text{電場: } E = E_A + E_B = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad \left(= \frac{Q}{\epsilon_0 S} \right)$$

(1)

(1)
 q を持ち込んだときに、 q に働く力: $F = qE = q \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ (2)

電位差 (電圧): $V = Ed = \frac{\sigma}{\epsilon_0} d$ ($= \frac{d}{\epsilon_0 S} Q$)
 \uparrow
 $E = \frac{V}{d}$ (3)

電気容量: $Q = CV$ より、

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\sigma S}{\frac{\sigma}{\epsilon_0} d} = \epsilon_0 \frac{S}{d} \quad (4)$$

S に比例し、 d に反比例

$\hookrightarrow S$ を変化させて C を変化:

可変容量コンデンサ

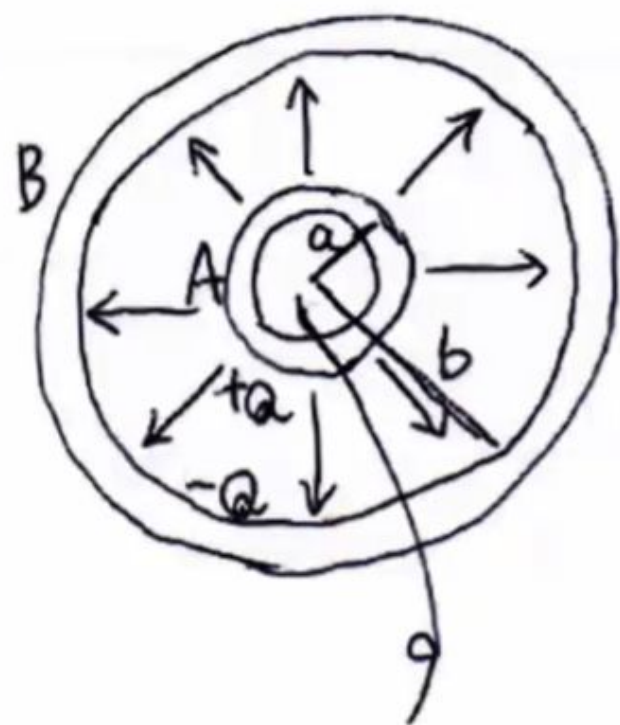
静電エネルギー: $u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$

$$U = uV_{\text{体}} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{\sigma}{\epsilon_0} \right)^2 \cdot Sd = \frac{Sd\sigma^2}{2\epsilon_0} \quad (5)$$

$$(\quad = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \cdot V = \frac{1}{2} QV)$$

2) 同心球殻コンデンサー (p.77, 例2)

半径 a と b ($a < b$) の同心球殻状の導体から作られるコンデンサーの電気容量を求めよ。



※ 中空でなく、

導体球でも
状況は同じ。

$$* C = \frac{Q}{V} \quad V = - \int_{\infty} E dr$$

- 電場は AB 間 ($a < r < b$) にのみ存在、
球対称のガウスの法則より、

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

- 電位差: $V = \phi_A - \phi_B$
$$= - \int_b^a E dr$$
$$= - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_b^a \frac{1}{r^2} dr$$

導体球でも
状況は同じ。

• 電位差: $V = \phi_A - \phi_B$

$$= - \int_b^a E dr$$

$$= - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_b^a \frac{1}{r^2} dr$$

$$= - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} [-r^{-1}]_b^a$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

• 電気容量: $C = \frac{Q}{V}$

$$= 4\pi\epsilon_0 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)^{-1}$$

$$= 4\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b-a}$$

※ 幾何学的な大きさで
決まる。

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

・電気容量: $C = \frac{Q}{V}$

$$= 4\pi\epsilon_0 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)^{-1}$$

$$= 4\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b-a}$$

※幾何学的な大きさで決まる。

(p.83、演習[1])

半径 a の孤立導体球の電気容量 C を求めよ。

$$b \rightarrow \infty \text{ とすると、 } C_A = 4\pi\epsilon_0 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{\infty} \right)^{-1} = 4\pi\epsilon_0 a //$$

また、無限遠方の電位 $\phi_B = 0$ とすれば、 $V = \phi_A - \phi_B = \phi_A$

$$\rightarrow Q_A = C_A V = C_A \phi_A \text{ より、 } C_A = \frac{Q_A}{\phi_A} //$$